



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS



Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería

PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO, FCQeI



Nombre del Investigador: Dr. Outmane Outbram

Área del conocimiento: Semiconductores

Líneas de investigación: Investigar, estudiar y analizar las propiedades eléctricas y ópticas de dispositivos nanoelectrónicos

Últimas publicaciones:

1. Gutierrez-Reyna, B. D., Zarhri, Z., Gaggero-Sager, L. M., & Oubram, O. (2025). Transport and thermoelectric properties of periodic and aperiodic germanene gated superlattices. *Materials Science in Semiconductor Processing*, 200, 109900.
2. Cisneros-Villalobos, L., Vera-Dimas, J. G., Martínez-Martínez, D., Oubram, O., & López-Sesenes, R. (2025). Influence of Grading Capacitance on Sympathetic Inrush Current of Parallel Power Transformers Influence de la capacité de répartition sur le courant d'enclenchement sympathique des transformateurs de puissance en parallèle. *IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering*.
3. Miniya, M., Espejel-Morales, R., Vázquez, R. M. D. C., & Oubram, O. (2025). Disorder in Self-Similar Structure Based Graphene Monolayer. *Journal of Physics: Condensed Matter*.
4. Oubram, O., Rodríguez-Vargas, I., & Guzmán, E. J. (2025). Disorder impacts on transport and magnetoresistance properties in a gapless ferromagnetic/normal/ferromagnetic phosphorene junction. *Journal of Physics: Condensed Matter*, 37(21), 215302.
5. Rabanales-Marquez, E., Noverola-Gamas, H., Oubram, O., & Gaggero-Sager, L. M. (2025). Effects of dopant interlayer distance, magnetic field and electric field on nonlinear optical rectification, second and third harmonic generation in double δ -doped quantum wells. *Solid State Communications*, 115951.

Contacto: oubram@uaem.mx

